

ZL8D16S3P 型瞬态电压抑制二极管阵列

1 特性

- 采用外延平面结构；
- 低电容，响应速度快；
- 静电敏感等级：非敏感；
- 封装外形：SOD-523。

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611、Q/RBJ1016QZ	G+：Q/RBJ1016QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级：Q/RBJ-GL-02JS-01A	

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

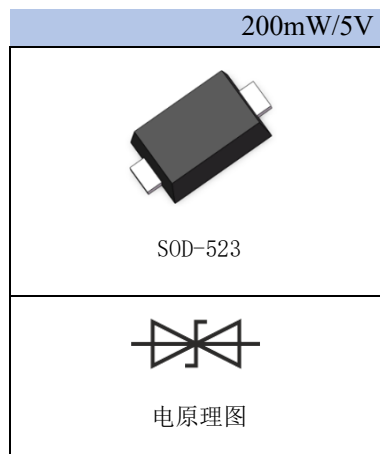
参数	P_{PPM} $t_p=8/20\ \mu\text{s}$ mW	I_{PP} $t_p=8/20\ \mu\text{s}$ A	V_{RWM} V	T_{OP} $^{\circ}\text{C}$	T_j $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$
产品型号						
ZL8D16S3P	200	5.0	5.0	-55~125	-55~150	-55~150

4 主要电特性

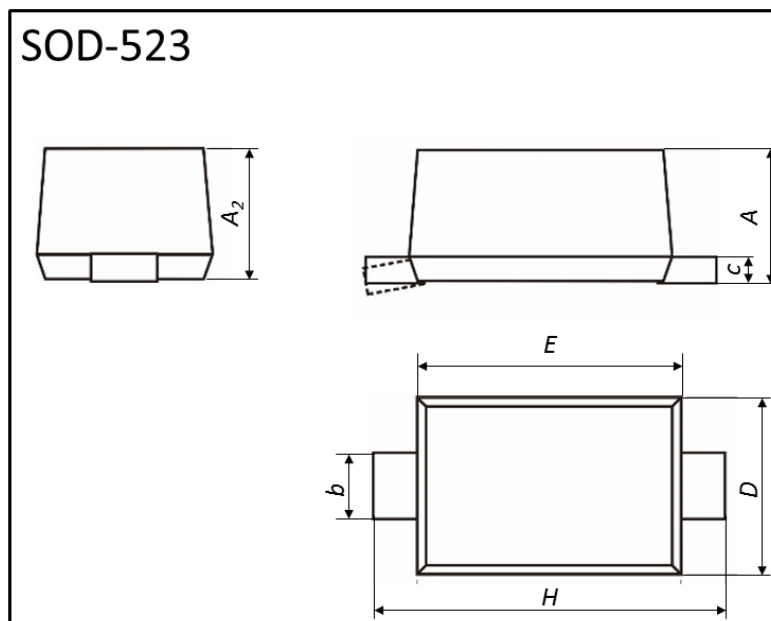
主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数符号	测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
1	V_{BR}	$I_R=1.0\text{mA}$	5.6	—	8.2	V
2	V_C	$I_{PP}=5.0\text{A}$	—	—	11	V
3	I_R	$V_R=\pm 5.0\text{V}$	—	—	1.0	μA
4	C_j	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$	—	13	—	pF



5 外形尺寸图



单位:mm

符号 尺寸	A	A_2	b	c	D	E	H
最小值	0.51	0.50	0.25	0.08	0.64	1.00	1.35
最大值	0.74	0.70	0.38	0.17	0.96	1.40	1.85

图 1 SOD-523 外形尺寸图